

#### 光ファイバ材料のXAFS法による構造解析

#### ガラス・セラミックス研究会 2010/8/27

#### 住友電気工業(株) 解析技術研究センター 飯原順次



#### 情報通信:銅/電気からガラス/光へ・・・



## 光増幅器とEr添加ファイバ(EDF)



Analysis Technology Research Center

#### 増幅スペクトルの添加元素依存性



4



バルクガラスでの評価

#### 実ファイバでの評価事例はない



# 目的と手法: EDF構造解析⇒機構解明



試料番号 -	コア組成		
	Er/wt.ppm	Al/wt.%	Ge/wt.%
Α	840	0	3.9
В	1357	1.4	3.4
С	1022	3.7	3.8
D	958	6.5	4.1
標準試料; Er-metal, Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
低濃度 ファイバ換算 < 10 wt. ppm			

# 何らかの高感度化対策が不可欠

ファイバとフリフォームの違い

#### ファイバではなくプリフォーム(コア材のみ) での解析では不可なのか?

#### ファイバとフリフォームで明らか にErの状態が異なる

# ファイバでの評価が必須



プリフォームとファイバの比較



# 高感度化の方策

#### 1. 試料濃縮

#### 2. 高感度検出器の利用



## XAFS測定方法

# 〇XAFS測定条件 入射X線検出器: 17 cm イオンチャンバー、N<sub>2</sub>フロー 透過X線検出器: 31 cm イオンチャンバー、N<sub>2</sub>フロー 蛍光X線検出器: 7素子SDD検出器

素子面積; 5 mm<sup>2</sup>×7 試料一検出器距離; < 10 mm





#### 蛍光法測定時のレイアウト

Analysis Technology Research Center







#### 結果:XAFSで得られた動径構造関数



## Er-0結合距離: 試料Aが他のEDFより短距離



Analysis Technology Research Center

## 結果:Er-0 配位数の変化



14

#### Er-0結合距離 AI無添加ではAI添加に比べて短距離

#### Er-0配位数 Al濃度高くなると配位数増大



### X線散乱で得られる動径分布関数



Analysis Technology Research Center

MDシミュレーション

# $\varphi$ <u>2-body Potentials</u>

(\*) confirmed the stability when applied to crystalline structures. (ex. Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>, etc)

#### **Structure Model**

~3000 atoms in Cell
20000 steps @4000 K (10<sup>-15</sup> sec/step)

# **Calculation RDFs** <u>and Coordination</u>





(stable configuration)



## X線散乱による構造解析



Analysis Technology Research Center



#### MDシミュレーション結果: Er-0配位数



Analysis Technology Research Center

#### MDシミュレーションによるErまわりの構造解析





Analysis Technology Research Center



XAFSおよびX線散乱法を用いてEDFの構造解析を行った。

・Al添加濃度が高くなると、Er-0配位数が大きくなる ・Al添加により、Er-0結合距離が長くなる

#### MDシミュレーションを用いた考察 ・Er-0の結合距離、配位数変化は第2近接原子のAIの効果

#### シミュレーションにより、新規添加元素を予測 試作、分析により効果を確認

